

УДК 533.9

**ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В СМЕСЯХ
 $\text{Ne} + \text{F}_2$ и $\text{He} + \text{F}_2$**

B. B. Зайцев, Е. Ю. Зверевская, В. Д. Климов и В. А. Савельев

Исследованы спектры испускания положительного столба тлеющего разряда в смесях $\text{Ne} + \text{F}_2$ и $\text{He} + \text{F}_2$ при изменении парциального состава компонент от 0 до 100%. Показано, что наблюдаемые зависимости от параметров горения разряда связаны с различием в потенциалах возбуждения и изменении физических параметров плазмы в присутствии отрицательных ионов.

Успехи, достигнутые в лазерной технике на эксимерах ЭГ (Э — атом благородного газа, Г — галоген) [1-3], а также возможность в условиях низкотемпературной плазмы положительного столба тлеющего разряда в смесях $\text{Xe} (\text{Kr}) + \text{F}_2$ синтеза фторидов ксенона и криптона [4] обусловливают определенный интерес к исследованию спектральных характеристик и электрических параметров такой плазмы. Первой стадией образования соединений в неравновесной гетерогенной системе со стабилизацией продуктов в конденсированной фазе является как, например, в случае синтеза KrF_2 образование атомов фтора в газовой фазе [5]



с последующим образованием в пленке криптона на охлажденной стенке промежуточного соединения KrF . Однако при этом не исключается участие возбужденных атомов и радикалов [5-7]. Поскольку как скорость получения инверсной заселенности ЭГ*, так и скорость образования фторидов криптона и ксенона связаны с парциальным составом смесей и параметрами разряда [3, 7, 8], представляется необходимым выполнить исследование скоростей возбуждения отдельных компонентов системы при различных условиях поддержания плазмы.

В настоящей работе устанавливается связь интенсивностей линий и полос в видимой области спектра положительного столба тлеющего разряда в He , Ne , F_2 и смесях $\text{He} + \text{F}_2$, $\text{Ne} + \text{F}_2$ с условиями возбуждения горения разряда. Экспериментальная установка и методика измерения электрических параметров плазмы [9] описаны в работах [10, 11]. В экспериментах использовались He и Ne спектральной чистоты. Фтор очищался низкотемпературной ректификацией до полного отсутствия в спектре линий и полос примеси. Разряд зажигался в приборе из молибденового стекла диаметром 14 мм с кварцевыми окнами и плоскими никелевыми электродами. При зондовых измерениях применялись никелевые зонды длиной 4 мм. Перед проведением исследований проводилась многократная промывка и тренировка разрядного прибора в исследуемом газе при заданных параметрах. Регистрация спектра разряда осуществлялась с помощью ФЭУ-79 и записью на КСП-4. Спектральная чувствительность схемы определялась с использованием распределения энергии в спектре лампы накаливания. Калибровка развертки барабана монохроматора проводилась по стандартным источникам Hg , Ne .

На рис. 1 представлена зависимость интенсивности линий и полос от тока и давления газа. С ростом разрядного тока значение интенсивностей переходов $3s' [1/2]^0 - 3p' [1/2]$ 5852.49 Å для Ne [¹³], $2sS - 3p'P^0$ 5015.68 Å⁰ для He и $C'\Sigma^+ - X^2\Pi$, $A^2\Pi - X^2\Pi$ [¹⁴] для F₂ увеличивается практически линейно. Такое изменение согласуется с представлением о возбуждении уровней атомов и молекул электронным ударом и слабой зависимости функции распределения электронов по энергиям от тока разряда [¹⁵].

Следовательно, скорости процессов



могут быть описаны уравнением

$$\Gamma_{(1)} = K n_e N, \quad (3)$$

где

$$K = \int_0^\infty U_{\text{нор.}} \sigma(u) F(u) \sqrt{u} du$$

коэффициент скорости реакции, $\sigma(u)$ — сечение возбуждения, $F(u)$ — функция распределения, N, n_e — концентрация частиц и электронов, U — вольт-эквивалент энергии.

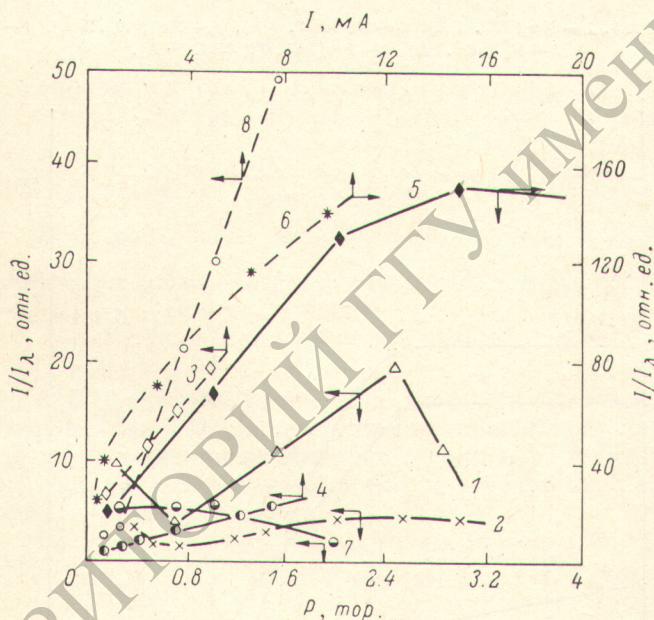


Рис. 1. Зависимость интенсивности излучения от давления и тока разряда.

1, 2 — 1 = 10 mA; 5, 7 — 1 = 3 mA; 3, 4, 6, 8 — $P = 3$ тор. 1 — F_2^{+*} (4513, 4533 Å), 2 — F_2^* (6517 Å), 3 — F_2^* (4825, 212 Å), 4 — F^* (7800, 212 Å), 5 — He (7065 Å), 6 — He (5015 Å), 7 — Ne (7032 Å), 8 — Ne (6402,25 Å).

Зависимость интенсивностей переходов (рис. 1) от давления разряда имеет более сложный характер. С ростом давления с одной стороны отсутствует линейный характер зависимости $n_e = f(p)$ [^{12, 15}], в то же время изменяются условия горения разряда. Если при низких давлениях ($p < 1.0$ тор для F₂ и $p < 3$ тор для инертных газов) разряд горит в диффузационном режиме, то при больших давлениях наблюдается контракция положительного столба тлеющего разряда, что связано с уменьшением электронной теплопроводности и изменением других физических параметров плазмы [¹¹].

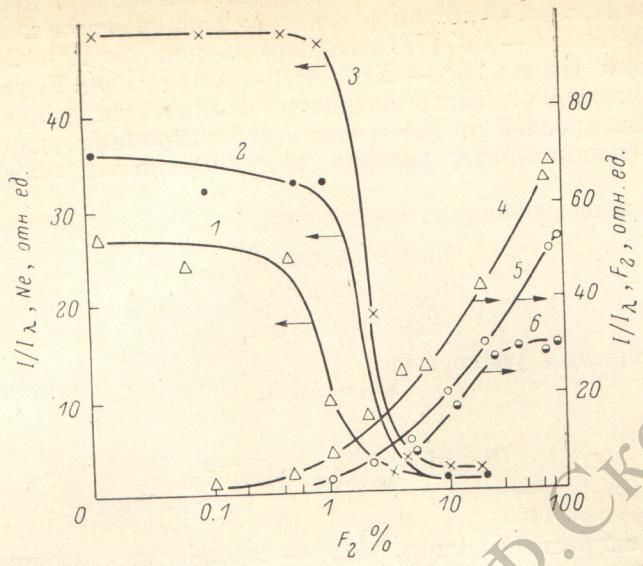


Рис. 2. Интенсивность спектра испускания положительного столба тлеющего разряда в смесях $\text{Ne} + \text{F}_2$.

$\Sigma P = 1$ тор, $I = 10$ мА. 1 — Ne (7032.41 Å), 2 — Ne (5842.49 Å), 3 — Ne (6402.25 Å), 4 — F_2^* (4823.0 Å),
5 — F_2^* (5495.7 Å), 6 — F^* (7800.212, 7754.695 Å).

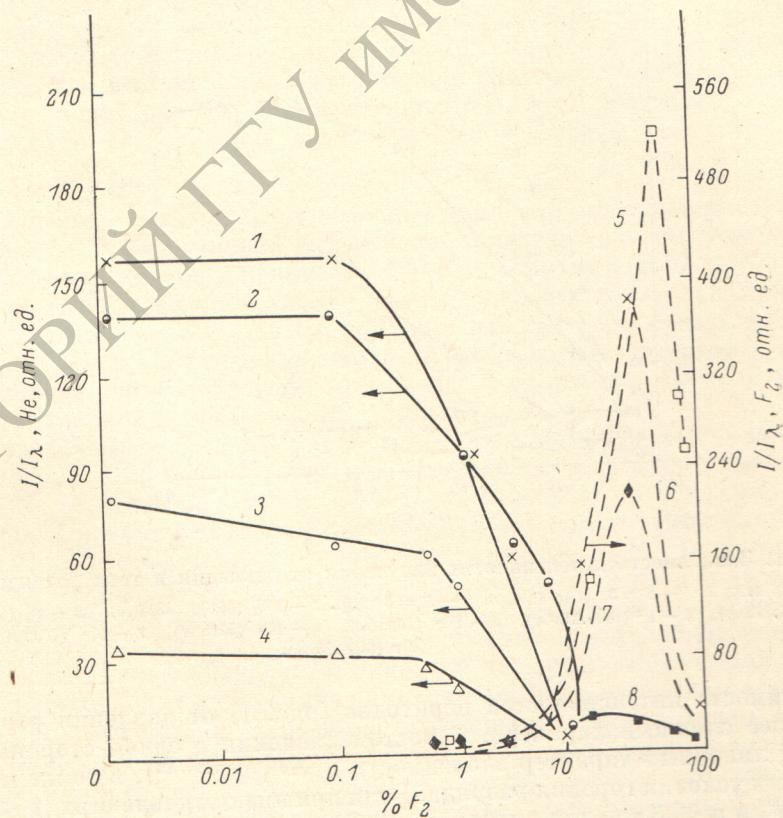


Рис. 3. Интенсивность спектра испускания положительного столба тлеющего разряда в смеси $\text{He} + \text{F}_2$.

$\Sigma P = 3$ тор, $I = 1$ мА. 1 — He (4471.48 Å), 2 — He (7065.19 Å), 3 — He (6560.4 Å), 4 — He (5875.62 Å);
5 — F_2^* (4825.0 Å); 6 — F_2^{+*} (4533.2, 4513.2 Å); 7 — F_2^* (6517.2 Å); 8 — F^* (7800.212, 7754.696 Å).

Возрастание роли ступенчатых процессов (тушения и т. д.) и контракция положительного столба приводят к уменьшению приведенной интенсивности излучения (рис. 1). Особенно резко меняется интенсивность перехода $A^2\Pi - X^2\Pi$ для F_2^+ , что позволяет предположить ступенчатый характер получения заселенности состояния $A^2\Pi$. Наибольший интерес представляет поведение интенсивностей излучательных переходов при изменении парциального состава смесей. На рис. 2, 3 представлена зависимость интенсивности излучения от процентного состава смесей $\text{Ne} + F_2$ и $\text{He} + F_2$. Из приведенных на рис. 2, 3 данных видно, что при концентрациях фтора до 10% в спектре разряда практически исчезают линии атомов Не и Не.

Такое поведение излучения связано, по-видимому, с более высокими порогами возбуждения электронных состояний Не и Не [13] по сравнению

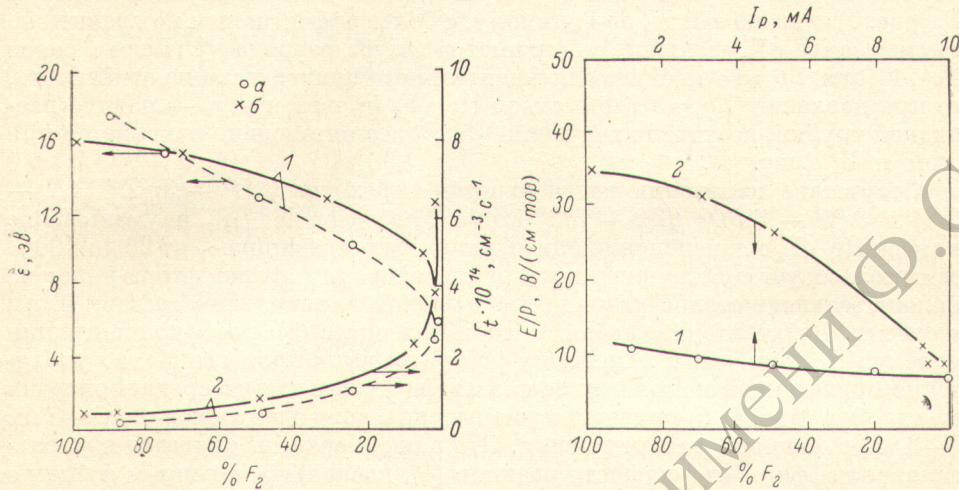


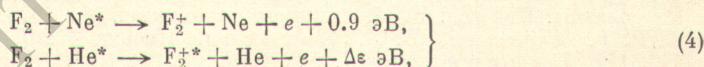
Рис. 4. Физические параметры в смесях $\text{Ne} + F_2$ и $\text{He} + F_2$.

α — $\text{Ne} + F_2$, β — $\text{He} + F_2$. $I = 3 \text{ mA}$, $\Sigma P = 3 \text{ тор}$. $\text{Ne} + F_2$: $I = 1 \text{ mA}$, $\Sigma P = 3 \text{ тор}$. 1 — средняя энергия электронов. 2 — Γ^+ — скорость диффузионной гибели зарядов.

Рис. 5. Связь приведенной напряженности электрического поля с условиями горения разряда.

1 — Не, $P = 3 \text{ тор}$; 2 — $\text{He} + F_2$, $P = 3 \text{ тор}$, $I = 3 \text{ mA}$.

с состоянием $C' \Sigma^+$ молекулы фтора [16]. Существенное изменение средней энергии электронов (рис. 4) и приведенной напряженности электрического поля (рис. 5) при изменении парциального состава F_2 в смесях позволяет предположить наличие безызлучательных переходов и участие возбужденных частиц в реакциях типа



не исключено наличие и других безызлучательных переходов и реакций [7]. Следует отметить, что изменение приведенной напряженности электрического поля более чем на порядок и температуры электронов \sim в 3 раза (рис. 4, 5) при значительном отличии потенциалов ионизации Не (24.5 эВ), Nn (21.56 эВ) и F_2 (15.8 эВ) [17] свидетельствует о возрастании роли объемных процессов в механизме гибели зарядов в присутствии отрицательных ионов, образующихся в реакции (1) диссоциативного прилипания [5]. О возрастании роли объемных процессов свидетельствует и снижение скорости диффузионной гибели зарядов Γ^+ более чем на порядок (рис. 4) при изменении состава смесей от 0 до 100% фтора. Если в чистых инертных газах скорость диффузионной гибели зарядов равна скорости прямой ионизации атомов электронным ударом [18]



то значительное уменьшение скорости гибели заряженных частиц на стенке с ростом ϵ и E/p (рис. 4, 5) с одновременным увеличением доли частиц с меньшим порогом ионизации или то же самое — с увеличением эффективности ионизации, — с одной стороны, свидетельствуют об изменении механизма гибели зарядов и преобладании объемной рекомбинации, с другой, обуславливает контракцию положительного столба, которая более эффективна при высоких давлениях [9]. Превышение приведенной напряженности электрического поля во фторе над E/p чистого Не, которая слабо меняется с током разряда (рис. 5) [9], может быть связано и с дополнительным механизмом гибели зарядов в реакции (1). Существенное изменение интенсивности излучения всех наблюдаемых переходов в смеси Не+F₂ ($A^2\Pi \rightarrow X^2\Pi$, $C' \Sigma^+ \rightarrow B' \Pi$, $3s^2P \rightarrow 3p^2D^0$) с ростом концентрации молекул F₂ (рис. 3) связано также, по-видимому, с более эффективным по сравнению со смесью Не+F₂ уменьшением диаметра шнура разряда [9]. Если в смеси Не+F₂ при $\Sigma p = 1$ тор сжатие положительного практически не отмечалось, то при давлении $\Sigma p_i = 3$ тор в смеси Не+F₂ (r_0/r)F₂, где r_0 — радиус разрядной трубки, достигало значения ~ 5 . Более интенсивно изменяется при этом и Γ_+ (рис. 4).

Отсутствие изменения интенсивности переходов $3s^2P - 3p^2D^0$ (1/2 — 3/2) и $3s^2P - 3p^2D^0$ (3/2 — 5/2) атома F в смеси Не+F₂ и уменьшение в смеси Не+F₂ с изменением концентрации молекул фтора \sim от 20 до 100% свидетельствует о затруднении процесса генерации атомов фтора в плазме положительного столба разряда при высоком парциальном составе фтора в смесях. Действительно, если в соответствии с (3) рост концентрации молекул F₂ приводит к линейному росту скорости процесса (1), то увеличение приведенной напряженности электрического поля и средней энергии электронов (рис. 4, 5) приведет к уменьшению доли электронов с энергиями 0—3 эВ в функции распределения. Это в свою очередь приведет к уменьшению коэффициента скорости реакции (1), поскольку максимум функции $\sigma(u)$ приходится на интервал энергий 0—3 эВ [15, 19]. Уменьшается с ростом F₂ и концентрация электронов [18].

В заключение авторы выражают глубокую признательность М. О. Буланину за ряд полезных консультаций и обсуждение по теме, а также за помощь в подборе литературы.

Литература

- [1] W. H. Long. Appl. Phys. Lett., 31, 393, 1977.
- [2] J. E. Velasquez, J. H. Kolts, D. W. Setser, J. Chem. Phys., 65, 3468, 1976.
- [3] Н. Г. Басов, А. А. Васильев, В. Н. Волков. Изв. АН СССР, 43, 239, 1979.
- [4] В. А. Легасов. Тез. IV Всесоюзн. совещ. по химии неорганических фторидов. «Наука», М., 1975.
- [5] В. А. Легасов, В. Д. Русланов, А. А. Фридман. В кн.: Химия плазмы. Под ред. Б. М. Смирнова. Атомиздат, М., 1978.
- [6] В. Г. Войтин, В. А. Легасов. Письма ЖТФ, 5, 1092, 1979.
- [7] С. Е. Куприянов, А. А. Перов, А. Н. Степанов. В Всесоюзн. конф. по физике низкотемпературной плазмы. Тез. докл., 371, Киев, 1979.
- [8] И. В. Никитин, В. Я. Родоловский. Усп. химии, 39, 1161, 1979.
- [9] В. Л. Грановский. Электрический ток в газе. «Наука», М., 1971.
- [10] В. В. Зайцев, Е. Ю. Зверевская, В. Д. Климон. ЖФХ, 51, 1243, 1978.
- [11] В. В. Зайцев, Е. Ю. Зверевская, В. Д. Климон. ЖТФ, 48, 1541, 1978.
- [12] В. В. Зайцев. ЖТФ, 42, 1894, 1972.
- [13] А. Р. Стриганов, Н. С. Свентицкий. Таблицы спектральных линий нейтральных и ионизированных атомов. Атомиздат., М., 1966.
- [14] T. L. Porteg. J. Chem. Phys., 48, 2071, 1968.
- [15] В. В. Зайцев. Автореф. канд. дисс., ИХФ АН СССР, М., 1973.
- [16] E. A. Colbourg, M. Dagenais, A. E. Douglas, J. W. Rayman. Canad. J. Phys., 54, 1343, 1976.
- [17] Б. М. Смирнов. Физика слабоионизированного газа. «Наука», М., 1979.
- [18] В. В. Зайцев. ТВТ, 16, 1152, 1978.
- [19] J. J. De Goppo, P. Steiger. J. Chem. Phys., 5, 936, 1970.

Поступило в Редакцию 27 марта 1980 г.